

**DLI-MOCVD를 이용한  $\text{La}_2\text{O}_3$  박막의 증착과  
전구체 평가**  
**(Deposition of  $\text{La}_2\text{O}_3$  thin film using DLI-MOCVD and  
evaluation of precursors)**

포항공과 대학교 화학공학과 강상우, 이시우

### 1. 서론

현재 빠른 속도로 반도체 소자의 집적도가 증가하고 있으며 소자의 성능을 향상시키기 위해 많은 노력을 하고 있다. 특히 게이트 산화막(gate oxide)으로 사용하고 있는  $\text{SiO}_2$ 의 한계를 극복하고자 하는 연구가 진행 중이다. 하지만  $0.1 \mu\text{m}$ 보다 작은 소자를 구현하기 위해서는 게이트 산화막으로 사용된  $\text{SiO}_2$  두께가  $10 \sim 15\text{\AA}$  정도는 되어야 한다. 이는  $\text{SiO}_2$ 를 사용할 수 없는 영역이며 반드시 고유전상수를 가진 물질로 대체하여야 하는 영역이다.

본 실험에서 증착한  $\text{La}_2\text{O}_3$ 은 유전 상수가  $20 \sim 27$  정도로  $\text{SiO}_2$ 의 3.9보다 7배 정도 큰 유전상수를 가지고 있으며 Si 계면에서 열역학적으로 안정하다고 알려진 물질이다. 이러한 좋은 물성을  $\text{SiO}_2$ 를 대체하기에 적합한 물질이다.  $\text{La}_2\text{O}_3$  박막을 증착하는데 사용한 DLI(Direct Liquid Injection)-MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) 공정은 고집적화된 소자를 만드는데 반드시 사용되어야 할 공정이며 이를 공정에 적용하기 위해서는 적합한 전구체의 선택과 공정 최적화에 대한 연구가 필요하다.

### 2. 실험방법

증착을 위해 사용된 전구체는  $\text{La}(\text{tmhd})_3\text{-TETEA}$  ( $\text{tmhd}=\text{tetramethylheptadionate}$ , TETEA=triethoxytriethyleneamine)이다. 전구체를 증착에 사용하기 전에 전구체의 열분해 특성을 확인하기 위해 TGA(Thermogravimetric Analysis) / DSC(Differential Scanning Calorimetry)를 이용하였으며 이 결과를 다른 La 전구체인  $\text{La}(\text{tmhd})_3\text{-PMDT}$  (PMDT=pentamethyldiethylenetriamine)와 비교하였다.

전구체를 평가한 후  $0.05\text{ M}$ 로 cocktail source를 만들어 증착에 사용했다. 이 용액은 DLI 시스템 (액체펌프와 vaporizer로 구성)으로 주입되며, 액체펌프로 주입량을 조절한다. 반응기체는  $\text{O}_2$  ( $350\text{ sccm}$ )를 사용하였고, 운반기체는 Ar ( $150\text{sccm}$ )을 사용하였다. 반응기의 전체 압력은 2 torr이고, 기판온도는  $325 \sim 450^\circ\text{C}$ 의 범위에서 실험하였다. 증착에 사용한 기판은 Si wafer이다. 증착한 박막의 결정성을 확인하기 위해 XRD(X-ray Diffraction Spectroscopy)를 이용하였고, 전기적 특성은 C-V와 I-V meter로 확인하였다.

### 3. 실험결과

전구체의 안정성을 확인하기 위해 열분석을 수행하였다. 열분석 결과  $\text{La}_2\text{O}_3$  박막 증착에 사용된  $\text{La}(\text{tmhd})_3\text{-TETEA}$ 는  $320^\circ\text{C}$ 까지 분해가 일어나지 않는 것을 확인하였다. 또한 기화가 되기 시작하는 온도를  $\text{La}(\text{tmhd})_3\text{-PMDT}$ 와 비교해 본 결과 TETEA ligand를 붙인 전구체가  $50^\circ\text{C}$  정도 낮은 온도에서 기화하는 것을 확인할 수 있었다.

$0.05\text{ M}$ 을 기화기에  $0.1\text{ ml/min}$ 의 속도로 주입하여 증착한  $\text{La}_2\text{O}_3$  박막을 기판온도에 따라 증착속도를 측정하였다. 분석 결과  $\text{La}(\text{tmhd})_3\text{-PMDT}$ 를 사용하였을 경우보다 증착속도가 20% 증가한 것을 확인하였다. 이는 전구체의 기화특성이 ligand를 붙이므로 해서 개선되었다는 것을 의미한다.

기판온도를 변화시켜 증착한 박막의 결정성을 분석한 결과  $325^\circ\text{C}$ 에서 증착된 박막은 cubic상만을 보이지만,  $375^\circ\text{C}$  이상에서 증착한 박막은 cubic 상과 더불어 hexagonal상이 같이 보이기 시작한다. 또한  $600^\circ\text{C}$ 에서 열처리 후 결정성을 확인해 보면 cubic상은 사라지고 hexagonal 상만을 관찰할 수 있었다.